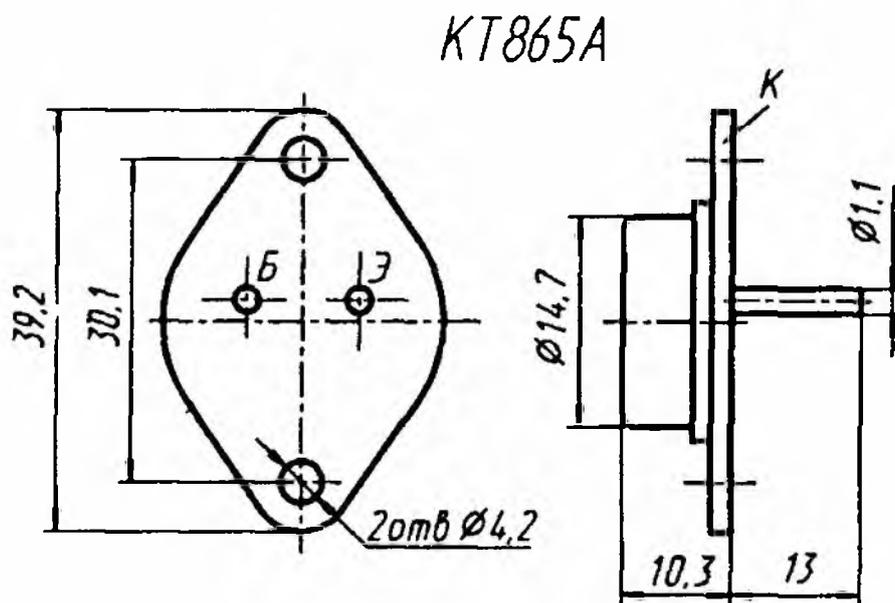


## КТ865А

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры  $p-n-p$  импульсный. Предназначен для применения в источниках вторичного электропитания, преобразователях, оконечных каскадах усилителей звуковой частоты, стабилизаторах напряжения. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний» г. Брянск.



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кб} = 4$  В,  $I_3 = 2$  А:

$T = +25$ °С .....	40...200
$T = +125$ °С .....	40...250
$T = -60$ °С .....	15...200

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 10$  В,  $I_k = 0,2$  А, не менее .....

типичное значение .....

Граничное напряжение при  $I_k = 0,05$  А, не менее .....

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при  $I_k = 6$  А,  $I_б = 0,6$  А, не более .....

типичное значение .....

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_K = 6 \text{ А}$ , $I_B = 0,6 \text{ А}$ , не более .....	2 В
типичное значение .....	1* В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 200 \text{ В}$ , не более:	
$T = +25 \text{ °С}$ .....	0,1 мА
$T = +125 \text{ °С}$ .....	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 6 \text{ В}$ , не более .....	3 мА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ , не более .....	300* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5 \text{ В}$ , не более .....	2000* пФ

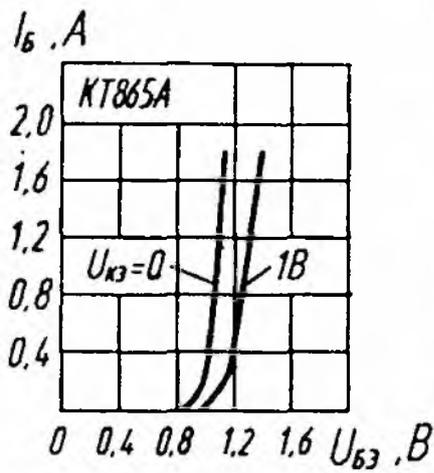
### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база при $dU_{КБ}/dt \leq 200 \text{ В/мкс}$ .....	200 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ Ом}$ , $dU_{КЭ}/dt \leq 200 \text{ В/мкс}$ .....	200 В
Постоянное напряжение база—эмиттер .....	6 В
Постоянный ток коллектора .....	10 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1 \text{ мс}$ , $Q \geq 2$ .....	15 А
Постоянный ток базы .....	2 А
Импульсный ток базы при $t_{и} \leq 1 \text{ мс}$ , $Q \geq 2$ .....	4 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60...+25 \text{ °С}$ :	
с теплоотводом <sup>1</sup> .....	100 Вт
без теплоотвода <sup>2</sup> .....	1,5 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-60... $T_K = +125 \text{ °С}$

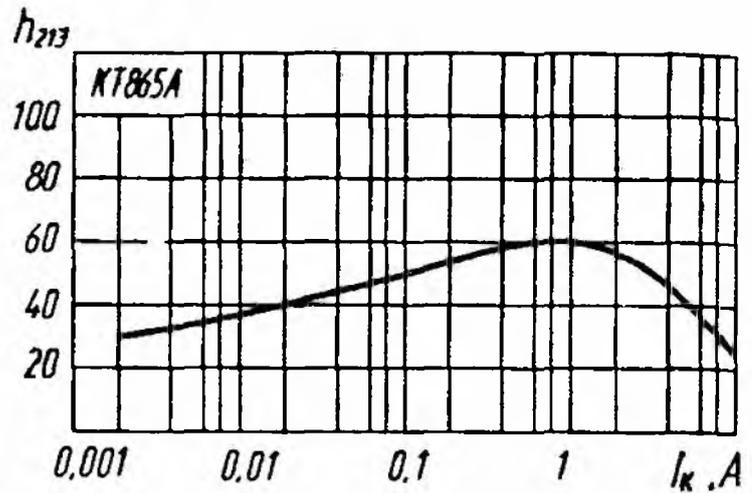
<sup>1</sup> При  $T_K = +25...+125 \text{ °С}$   $P_{K, \text{МАКС}}$  снижается линейно до 20 Вт.

<sup>2</sup> При  $T_K = +25...+125 \text{ °С}$   $P_{K, \text{МАКС}}$  снижается линейно до 0,3 Вт.

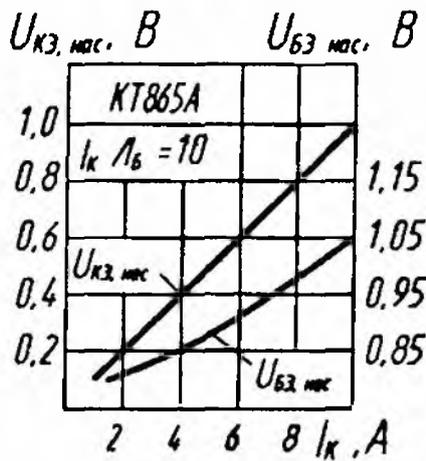
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более +270 °С в течение не более 3 с, время лужения не более 2 с. Допускается не более двух перепаек выводов.



Входные характеристики



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора